



# 第63回 半導体・集積回路技術シンポジウム

2002年 12月12日(木)・13日(金)

機械振興会館ホール(東京都港区芝公園 3-5-8 Tel. 03-3434-8216)

第1日

12月12日(木) 9:55~16:55

<9:55~10:00>

Introductory Talk

<10:00~10:50>

1. 招待講演 HfO<sub>2</sub>ゲート絶縁膜を用いたCMOSデバイス

富士通研究所: 青山敬幸

<10:50~11:15>

2. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/SiO<sub>2</sub>積層ゲートMISFETにおける移動度低下機構

日立中研<sup>1</sup>, 日立半導体事業部<sup>2</sup>, IMEC<sup>3</sup>, ASM<sup>4</sup>: 斎藤慎一<sup>1</sup>,  
嶋本泰洋<sup>1</sup>, 外村修<sup>1</sup>, 鳥居和功<sup>1</sup>, 久本大<sup>1</sup>, 眞邊由起子<sup>2</sup>,  
Matty Caymax<sup>3</sup>, Jan Willem Maes<sup>4</sup>, 由上二郎<sup>1</sup>, 平谷正彦<sup>1</sup>,  
尾内亨裕<sup>1</sup>, 木村紳一郎<sup>1</sup>

<11:15~11:40>

3. ヘリウムアニールによるシリコン基板上ジルコニア、  
ハフニア及びシリケート膜のシリサイド化抑制  
(株)東芝研究開発センター: 村岡浩一

<11:40~12:05>

4. FETの駆動能力の向上のためのHfO<sub>2</sub> MIS構造への酸窒化

シリコン界面制御

MIRAI 産総研<sup>1</sup>, MIRAI ASET<sup>2</sup>, 東京大学<sup>3</sup>: 太田裕之<sup>1</sup>,  
安田直樹<sup>2</sup>, 安田哲二<sup>1</sup>, 森田行則<sup>1</sup>, 宮田典幸<sup>1</sup>, 富永浩二<sup>2</sup>,  
門島勝<sup>2</sup>, 右田真司<sup>1</sup>, 生田目俊秀<sup>2</sup>, 鳥海明<sup>1,3</sup>

<12:05~13:20>

昼食

<13:20~14:10>

5. 招待講演 SoCに向けたSOI DRAM混載技術

東芝セミコンダクター社: 井納和美

<14:10~15:00>

6. 招待講演 FD-SOI デバイス技術

沖電気工業: 沖原将生

<15:00~15:25>

7. 急峻浅ハロー構造SOI-MOSFETにおける基板浮遊効果抑制作用

NEC シリコンシステム研, NEC R&D サポートセンター<sup>1</sup>: 黄剛昭,  
斎藤幸重<sup>1</sup>, 武村久, 新井浩一, 成広充, 若林整, 竹内潔, 最上徹

<15:25~15:40>

休憩

<15:40~16:05>

8. SOIウェーハの金属ゲッタリング技術

三菱電機: 成岡英樹, 岩松俊明, 一法師隆志, 服部信美

<16:05~16:55>

9. 招待講演 多結晶シリコン薄膜トランジスタの展開

東京農工大学: 鮫島俊之

<17:00~18:30>

- 懇親会

第2日

12月13日(金) 10:00~16:30

<10:00~10:50>

10. 招待講演 半導体微細加工技術を駆使した

バイオチップの創製  
東京大学: 堀池靖浩

<10:50~11:40>

11. 招待講演 化学・生化学へのMEMS技術の応用

早稲田大学: 庄子習一

<11:40~12:05>

12. 半導体バイオセンシングデバイスの構築に向けた

有機単分子テンプレートの形成

早稲田大学: 丹羽大介, 山田祐規子, 大道馨, 本間敬之,  
逢坂哲彌

<12:05~12:30>

13. Sn電析を用いた高感度X線マイクロカロリメータ作製

プロセスの研究

早稲田大学: 小林秀臣, 佐藤裕崇, 森健太郎, 工藤寛之,  
荒川貴博, 本間敬之, 逢坂哲彌, 庄子習一,  
石崎欣尚, 藤本龍一, 満田和久

<12:30~13:45>

昼食

<13:45~14:35>

14. 招待講演 65nm 世代配線技術

-配線間容量低減のための検討-

NEC: 多田宗弘

<14:35~15:00>

15. Low-k 材料信頼性の新しい課題: TDDI

日立製作所: 龍崎大介, 石田猛, 古澤健志

<15:00~15:25>

16. ポラジン-シロキサンポリマーとその応用

ASET, AIST<sup>1</sup>: 井上正巳, 関山有朗, 仲村恵右, 獅子口清一,  
福田琢也, 柳沢寛, 内丸祐子<sup>1</sup>, 甲田直子<sup>1</sup>

<15:25~15:40>

休憩

<15:40~16:30>

17. 招待講演 電子ビームによるハイパフォーマンス

Low-k膜の形成

東芝セミコンダクター社: 中田鍊平

参加申込締切(予約) 12月6日(金)迄に申込書式に従い費用を添えて(現金書留または銀行振込・みずほ銀行大岡山支店  
普通預金口座1926159 電子材料委員会小田俊理(オガシユリ宛)お申込み下さい。

銀行振込の際も氏名、勤務先、連絡先をご連絡下さい。

参加登録費(講演論文集1部、懇親会費を含む)

予約 会員 20,000円 会員外 22,000円 大学関係 5,000円 (1日のみ 会員 14,000円 会員外 15,000円)

当日 会員 22,000円 会員外 24,000円 大学関係 6,000円 (1日のみ 会員 15,000円 会員外 16,000円)

講演論文集のみ希望の場合、1部6,000円でお分け致します。

参加申込、論文集申込先 〒102-0074東京都千代田区九段南4-8-30アルス市ヶ谷202

電気化学会電子材料委員会(TEL: 03-3234-4213, FAX: 03-3234-3599)

電気化学会電子材料委員会 主催

応用物理学会、高分子学会、精密工学会、電気学会、電子情報通信学会、日本印刷学会、日本化学会、  
日本金属学会、日本セラミックス協会、日本写真学会、日本表面科学会、日本真空協会、I/E/Oに於実装学会 協賛